

产品规格书

DATA SHEET

客户名称 : _____

产品名称 : 高压二极管

产品型号 : SHV-09

产品描述 : 玻璃钝化高压二极管

反向电压 9000V

正向电流 350mA

物料编码 : 无

制作 Prepared by	审核 Audit by	批准 Approved by
崔伟	黄晓艳	孙晓佳

客户确认

Customer Signature

乐山希尔电子股份有限公司

中国，四川省，乐山市高新技术开发区南新路 9 号 (614000)

网址 : www.share-leshan.com.cn 邮箱 : Sales@share-leshan.com.cn

电话 : 0833-2595818/2595870 传真 : 0833-2595622

Glass and SIPOS Passivation High Voltage Diodes**玻璃与SIPOS钝化工艺高压二极管****特征 Features**

玻璃SIPOS钝化工艺芯片

Glass and SIPOS passivation chip

高反向电压

High Reverse Voltage

低反向漏电流

Low Reverse Leakage Current

高耐浪涌电流能力 20 安培

High surge current capability to 20 Amperes

符合ROHS要求

ROHS compliance

高温焊接保证 : 260°C±5°C/10秒

High temperature soldering guaranteed: 260°C+5°C/10 seconds

机械参数 Mechanical Data

本体 : 塑封壳体

Case: Molded plastic case

终端 : 电镀引线可焊性每符合MIL - STD - 750 , 方法2026

Terminals: Plated leads solderable per MIL-STD-750, Method 2026

极性 : 管体标记

Polarity: Marked on Body

安装位置 : 任何

Mounting Position: Any

重量 : 2.4克 (大约)

Weight: 2.4g (Approximately)

产品适用范围 Product scope of application

适用于 “变频微波炉” 高压整流

For high voltage rectification for “MWO of frequency conversion”

型号 Type	V _{RM} (V)
SHV-09	9000V

最大额定值 Maximum Ratings and Thermal Characteristics @ Ta = 25°C unless otherwise noted				
参数名称 Item	符号 Symbol	参数条件 Conditions	数值 Rating	单位 Unit
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RM}		9000	V
平均正向电流 Average Forward Current	I _{F(AV)}	50Hz 正弦波负载, T _c ≤90°C 50Hz sine wave load, T _c ≤90°C	500	mA
		50Hz 正弦波负载, T _c ≤105°C 50Hz sine wave load, T _c ≤105°C	350	
最大正向浪涌电流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波,一个周期, t=10ms, T _j =25°C 50Hz sine wave, 1 cycle, t=10ms, T _j =25°C	20	A
存储温度 Storage Temperature	T _{stg}		-40~130	°C
结温 Junction Temperature	T _{j(max)}		120	°C

电气特性 Electrical Characteristics @ Ta = 25°C unless otherwise noted					
参数名称 Item	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	数值 Rating	单位 Unit	
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	V _F	I _F =350mA, 脉冲测试 I _F =350mA, Pulse measurement	T _a =25°C	13.0max	V
反向峰值电流 Peak Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , 脉冲测试, 单个二极管的额定值 V _R =V _{RM} , Pulse measurement, Rating of per diode	T _j =25°C	10.0max	uA
反向恢复时间 Reverse recovery time	T _{rr}	I _F =I _R =100mA, 90% recovery point	T _j =25°C	150max	ns
反向击穿电压 Reverse Breakdown Voltage	V _Z	I _R =100uA	T _j =25°C	9.5min	KV
热阻 Thermal resistance	R _{th} (j-c)	结到管壳的热阻,无散热片 Junction to case, without heatsink	T _j =120°C V _R =0V	12.8	°C/W

特性曲线 Rating Characteristic

FIG.1 . Derating Curve For Output Rectified Current

图 1. 电流降额曲线

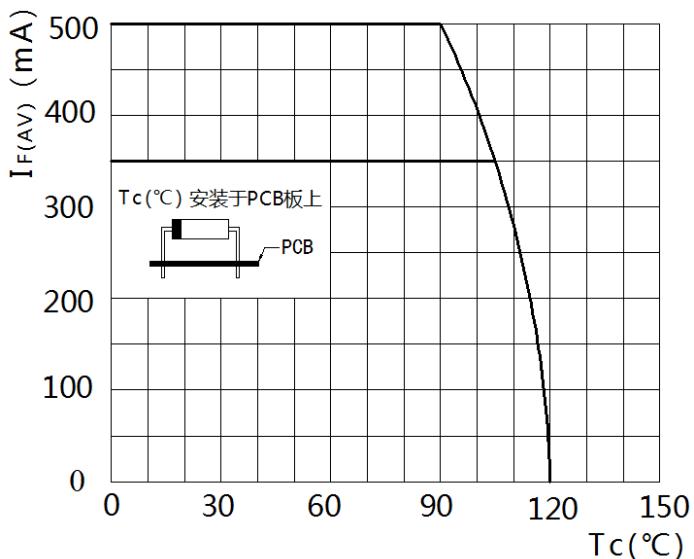


FIG.2 . Maximum Non-Repetitive Peak Orward Surge Current Per Bridge Element

图 2. 最大正向不重复峰值浪涌电流

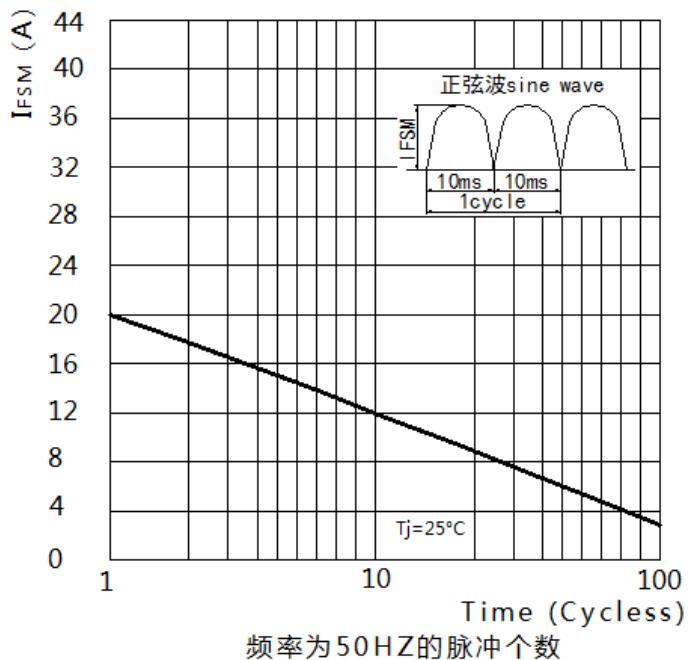


FIG3.Typical Reverse Characteristics Per Bridge Element

图 3. 典型反向特性

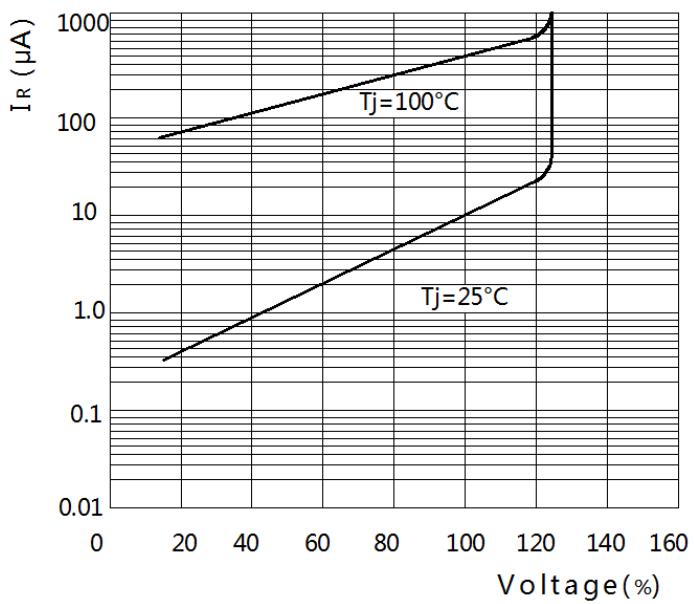
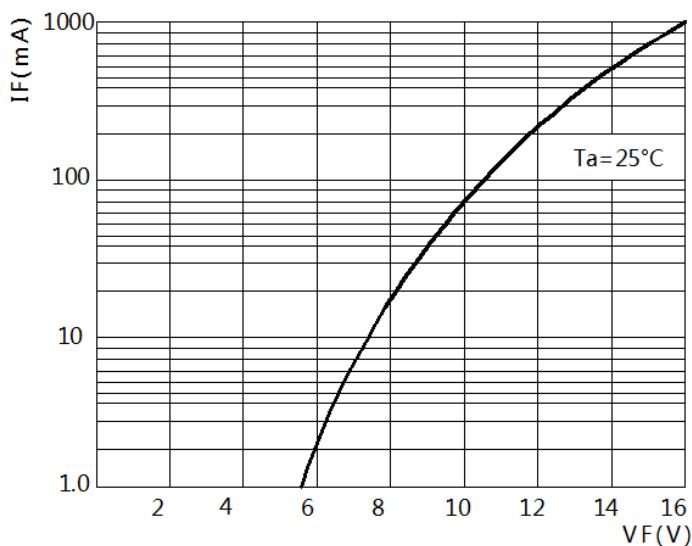
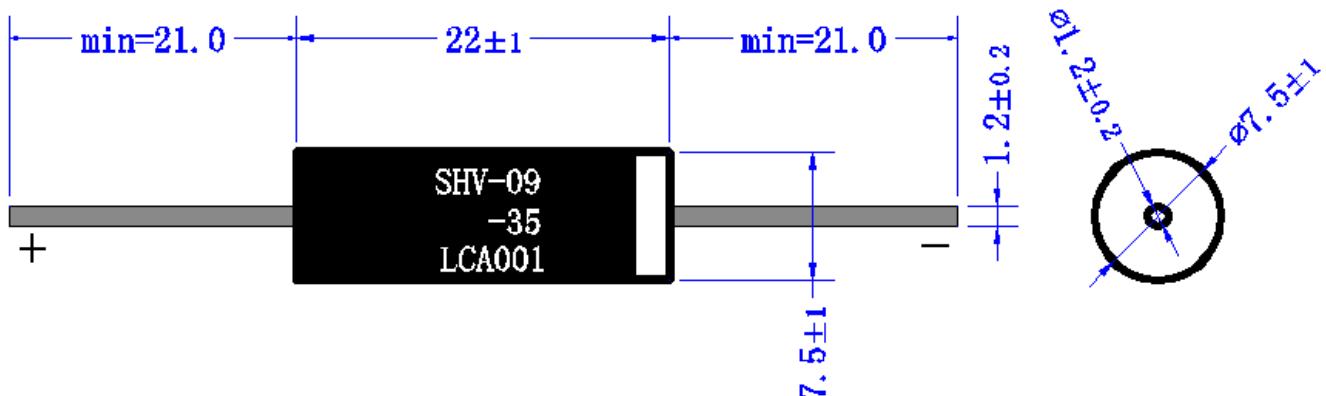


FIG4.Typical Forward Characteristics Per Bridge Element

图 4. 典型正向特性



尺寸图 Dimensioned drawing



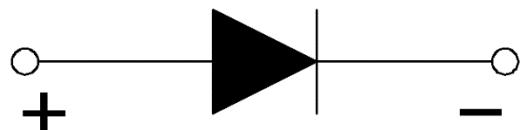
印字标识说明：

SHV-09 : S表示希尔，HV代表高压二极管，-09表示电压9000V。

-35 : 表示 $I_O = 350\text{mA}$ 。

HIA001 : 制程周期码

线路图 Circuit diagram



注意事项 Attention

1、引脚折弯

■ 引线允许一次 $\leq 90^\circ$ 折弯，严禁出现 $\geq 180^\circ$ 回折和扭曲；

2、焊接设备

■ 焊接条件： $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}/10\text{秒}$ ，定期检测温度，禁止超温；

存储 storage

1、存储

■ 在温度： $25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 60\%$ ，通风环境下，存储周期6个月；

■ 包装完整，防止纸箱淋湿和吸潮；

■ 如超过存储周期使用，建议在 100°C 条件下，烘烤 $2\text{-}4\text{h}$ 去除表面潮气；